

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成 19 年 10 月 18 日 (2007.10.18)

【公開番号】特開 2006-69816 (P2006-69816A)

【公開日】平成 18 年 3 月 16 日 (2006.3.16)

【年通号数】公開・登録公報 2006-011

【出願番号】特願 2004-252698 (P2004-252698)

【国際特許分類】

C 0 1 B 31/02 (2006.01)

B 8 2 B 3/00 (2006.01)

H 0 5 H 1/00 (2006.01)

H 0 5 H 1/46 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 31/02 1 0 1 F

B 8 2 B 3/00

H 0 5 H 1/00 A

H 0 5 H 1/46 B

H 0 5 H 1/46 M

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 8 月 31 日 (2007.8.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板に立設し、二次元的な広がりをもち、それぞれの長さ方向が、所定方向に配向しカーボンナノ構造体から成るカーボンナノウォール。

【請求項 2】

少なくとも炭素を構成元素とする原料物質がプラズマ化したプラズマ雰囲気中を反応室の少なくとも一部に形成するとともに、そのプラズマ雰囲気中に該雰囲気の外部で生成したラジカルを注入して、該反応室中に配置した基材の表面にカーボンナノウォールを形成するカーボンナノウォールの製造方法において、

前記ラジカルの注入方向と、前記基板面の法線方向との成す平面が、前記基板面に垂直になるように前記基板を配置し、前記基板面に、印加する電界の方向を基板面に平行にすることで、前記基板上に成長する前記カーボンナノ構造体のそれぞれの長さ方向を所定方向に配向させたことを特徴とするカーボンナノウォールの製造方法。

【請求項 3】

前記基板面は、前記ラジカルの注入方向に垂直であることを特徴とする請求項 2 に記載のカーボンナノウォールの製造方法。

【請求項 4】

前記所定方向は、前記電界の方向であることを特徴とする請求項 2 又は請求項 3 に記載のカーボンナノウォールの製造方法。